高效率共轭聚合物主体绿光磷光发光二极管*

牛巧利† 章 勇 范广涵

(华南师范大学光电子材料与技术研究所 广州 510631) (2009 年 3 月 24 日收到 2009 年 4 月 28 日收到修改稿)

因电致发光效率高和器件制备工艺简单,聚合物为主体的绿色磷光电致发光成为一个研究热点.共轭聚合物 的三线态能级一般低于绿色磷光材料的三线态能级,易对磷光的发光引起猝灭导致低的发光效率,所以较少被用 作绿色磷光材料的主体.通过增加聚乙烯基咔唑(PVK)作为空穴传输层,获得了高发光效率的共轭聚合物聚芴 (PFO)作主体绿色磷光发射,甚至高于相同条件下以PVK为主体的绿色磷光发射.究其原因,PVK的电子阻挡作用 使发光中心靠近 PVK与 PFO的界面,界面处 PVK因为其高的三线态能级增强了绿色磷光的发光.当三(2-苯基吡 啶)I(I(ppy), 游杂浓度为 2%时得到了最高的亮度效率 24.8 cd/A,此时的电流密度为 4.65 mA/cm²,功率效率为 11 lm/W,最高亮度达到 35054 cd/m²,色坐标是(0.39 0.56).

关键词:共轭聚合物,磷光,绿光发光

PACC: 7865T, 7280L, 7860F, 7855K

1.引 言

聚合物为主体的磷光发光二极管,结合了磷光 材料的高发光效率和聚合物器件简单的溶液加工工 艺,已成为研究的一个热点.对于绿色磷光聚合物发 光二极管(PLED),目前的研究多采用非共轭聚合物 聚乙烯基咔唑(PVK)做主体材料^{12]},因为 PVK 具有 高于绿色磷光材料的三线态能级.但是 PVK 溶液的 黏度过大,且其在聚(3 A-二氧乙基噻吩))聚对苯乙 烯磺酸(PEDOT-PSS)上的接触角过小,不利于喷墨 打印,成为延缓高效率的绿色磷光在聚合物平板显 示屏中应用的原因之一.

聚芴类材料作为共轭聚合物材料中的一大类, 在显示应用领域已表现出极大的吸引力,因为它具 有高的发光效率、色纯度好的电致蓝光发射、高的电 荷迁移率和良好的成膜性等优势,是在 PLED 和聚 合物平板显示屏中使用最频繁的蓝光材料^{3→51}.但 是,因为共轭聚合物的三线态能级比绿色磷光配合 物(如三(2-苯基吡啶)-In(I(ppy),))低,一般认为从 In(ppy),到聚 (PFO)的反向能量传递将会大大增 强,导致磷光发光的猝灭^[6,7]. Sudhakar 等^[6]通过 Stem-Volmer 分析证实了芴低聚物(三聚芴)在溶液 中对绿色磷光发射具有较强的猝灭,且猝灭速率随 磷光材料三重态能级的升高而增大,并推测认为共 轭聚合物由于具有更低的三重态能级因而对磷光的 猝灭速率将更大.Chen 等^[7]通过对比在均聚芴(PF) 中分别掺杂四个具有不同三线态能级的铱化合物得 到的器件发光效率,也得出了类似的结论.由此看 来,想要用共轭聚合物作为主体材料来获取高发光 效率的三线态绿光似乎是比较困难的^{8]}.但在本文 中,我们通过采用 PVK 为空穴传输层,得到了以共 轭聚合物 PFO 为主体、铱配合物 Id(ppy),为绿色磷 光发光中心的高效率绿色磷光发射,发光效率甚至 高于相同条件下以 PVK 为主体的绿色磷光发射.此 高效率的 PFO 主体绿色磷光 PLED 的获得,对高效率 全彩色聚合物平板显示屏的研制有极大的推动作用.

实验发现,在光致发光(PL)过程中观察不到来 自 Lf ppy),的发光.电致发光 EL 过程中,没有 PVK 空穴传输层结构的器件在高浓度掺杂时也只能观察 到微弱的绿光发光;当增加 PVK 空穴传输层后,在 极低掺杂浓度时主体的发光就被完全猝灭了,得到 了高效率的绿光发射.当 Lf ppy),的掺杂浓度为 2% 时得到最高的亮度效率为 24.8 cd/A;此时的电流密

^{*} 广东省自然科学基金(批准号 106300928)和华南师范大学博士科研启动基金(批准号 :G21027)资助的课题.

[†] E-mail: qlniu@scnu.edu.cn

度为 4.65 mA/cm² 功率效率为 11 lm/W 最高亮度达 到 35054 cd/m².

2.实 验

PFO和 In(ppy)。均参照文献[9,10]的方法合成,其中 PFO 的重均分子量为 35000 g/mol,多分散系数是 2.2. PVK(平均分子量为 110 万,购于 Aldrich)和 2-(4-叔丁苯基)-5-联苯基 二唑(PBD) (购于 Aldrich)没有经过进一步的处理,直接使用. 图 1 给出了 In(ppy)。和 PFO 的分子结构式.



图 1 Li(ppy),和 PFO 分子结构式 (a)Li(ppy),(b)PFO

实验制备了器件 [和器件][两种结构器件.器件 [(无 PVK 传输层):铟锡氧化物(ITO)/PEDOT (50 nm)/PFO:Ir(ppy),(80 nm)/Ba(4 nm)/Al (150 nm);器件 [[(有 PVK 传输层):ITO/PEDOT (50 nm)/PVK(40 nm)/PFO:Ir(ppy),(80 nm)/Ba (4 nm)/Al(150 nm).两种器件的发光层是 PFO 与 In(ppy),以不同质量比共混,共混前先将 In(ppy),和 PFO 分别以 2.5 mg/ml 和 15 mg/ml 的浓度溶于二氯 苯和二甲苯中.器件制备过程可参考文献 11].

3. 实验结果与分析

图 2(a)给出了 I₁(ppy),的吸收光谱和 PFO 的 PL 光谱. 从图 2(a)可以看出,PFO 的发射光谱与 I₄(ppy),的吸收光谱有很大部分的重叠,满足了从 PFO 到 I₄(ppy),发生能量转移的必要条件^[12].然而 在 PFO 掺杂不同比例 I₄(ppy),的 PL 光谱中(以 380 nm 激光作为激发源),即使 I₄(ppy),在 PFO 中 的质量分数为 4%,都没有观察到来自 I₄(ppy),的绿 光发射.图 2(b)所示是 PFO 为主体掺杂不同质量分 数的 I₇(ppy),的 PL 光谱,只观察到峰值位于 438 nm 来自 PFO 的蓝光发射.

EL 过程中,对于器件 [,观察到了与上述类似



图 2 Id ppy)。和 PFO 的 PL 光谱 (a) Id ppy)。的吸收光谱和 PFO 的 PL 光谱 (b) PFO 掺杂不同质量分数 Id ppy)。的薄膜的 PL 光谱

的现象,即使掺杂 2% In(ppy)。也只能观察到非常 微弱的绿光发光.图 3 所示是 PFO 分别掺杂质量分 数为 0.1%,1% 和 2% In(ppy)。的器件 I 的 EL 光 谱,其中峰值位于 438 nm、肩峰 463 nm 的蓝光波段 是来自 PFO 的发光,当掺杂比例为 1% 以上时才能 看到峰值位于 500 nm 处来自 In(ppy)。的微弱绿光.

PL和 EL 过程的发光机理不同,PL 过程以能量 转移机制为主,而 EL 过程除了能量转移,还有电荷 陷阱机制¹³¹.在高浓度掺杂下,PL 和 EL 光谱中客 体发光微弱或没有观察到客体发光的现象,都是由 于从客体 Id(ppy),到 PFO 发生了能量后转移.下面 以 PFO 掺杂不同质量分数 Id(ppy),的溶液的 PL 光 谱实验为例来证明能量后转移的发生.图 4(a)所示 是 PFO 分别掺杂质量分数为 20%,40%,60% 和 80% Id(ppy),的溶液的 PL 光谱,激发光波长为 380 nm,即被激发的是主体 PFO.从图 4(a)可以看 出,自始至终 PL 光谱中只有蓝光发射,没有Id(ppy), 的发光,且 PFO 的发光强度随着 Id(ppy),掺杂比例 的增加而降低.用等体积的甲苯溶液代替混入 PFO



图 3 发光层为 PFO 分别掺杂 0.1%, 1%和 2% h(ppy), 的 EL 光谱



图 4 溶液的 PL 光谱 (a) PFO 中掺杂了 20%, 40%, 60% 和 80% L(ppy), (b) PFO 中掺入与 L(ppy), 相同体积的甲苯溶剂

溶液中的 L(ppy), 后测试 PL 光谱发现, PFO 发光强 度没有因为甲苯溶剂的稀释而降低, 如图 4(b)所 示.这说明 PFO 掺杂 L(ppy), 后发光强度的降低是 由 L(ppy), 引起的,从 PFO 到 L(ppy), 发生了能量 转移,同时因为主体 PFO 的三线态能级(2.3 eV)¹⁴¹ 低于客体 L(ppy),(2.4 eV),导致了从 L(ppy), 到 PFO 的能量后转移的发生. PFO 与 In(ppy)。间能量 转移关系如图 5 所示,对此做如下分析 (1)PFO 单 线态激子通过 Forster 能量转移(ET)传到 In(ppy)。的 单线态激发态 因 PFO 三线态能级低于 In(ppy)。的, 所以从 PFO 到 In(ppy)。没有 Dexter 能量转移发生. (2)In(ppy)。的单线态激发态的激子系间窜越到 In(ppy)。的三线态 T_1 .(3)由于 In(ppy)。的三线态高 于 PFO 的三线态 ,从 In(ppy)。到 PFO 发生能量后转 移(BET).

PFO 的三线态激子到其基态的直接跃迁是自旋 禁阻的,故激子通过非辐射衰减回到基态.因此,在 溶液的 PL 过程中观察到了 PFO 发光强度的降低. EL 过程中同样发生了从 In(ppy),到 PFO 的能量后 转移,因此最终只能观察到微弱的绿光发光.



图 5 PL 过程中主体 PFO 与客体 Id ppy)。之间能量转移示意图

当在器件 I 的基础上增加空穴传输层 PVK 后 (器件 II),器件的 EL 光谱呈现出另一番完全不同 的景象,如图 6 所示 PFO 掺杂不同浓度 h(ppy),的 器件 II 的 EL 光谱.从图 6 可以看到:掺杂 h(ppy), 浓度为 0.1%时,还能观察到微弱的蓝光发射;掺杂 浓度增加到 0.5%后,主体发光几乎被完全猝灭,只 能看到来自 h(ppy),的绿光.

器件 [] 的发光性能测试结果表明,绿光发光的 效率随着 I₄ ppy),掺杂浓度的增加呈现抛物线的变 化趋势,如图 7 所示.当 I₄ ppy),质量分数为 2%时, 亮度效率最高,为 24.8 cd/A,此时的电流密度为 4.65 mA/cm²,功率效率为 11 lm/W,最高亮度达到 35054 cd/m².相同条件下制备的以 PVK 40% PBD 为 主体掺杂 I₄ ppy),的器件,其亮度效率在掺杂 2% Ir (ppy),时出现极大值,得到的最高亮度效率为 20 cd/A,此时的电流密度为 7.7 mA/cm²,功率效率 为 4.7 lm/W 最高亮度为 17784 cd/m².由此可见,我 们在 PFO 体系中得到了高于 PVK 40% PBD 体系的 绿色磷光电致发光效率,与之前的报道不同^[6].



图 6 器件 [] 中 PFO 掺杂不同浓度 Id ppy), 的 EL 光谱



图 7 PFO 分别掺杂 0.1%, 1%, 2%和 4% I(ppy), 的器件 Ⅱ的 亮度效率-电流密度关系曲线

通过对比器件 I 和器件 II 的 EL 光谱可以看 出,PVK 空穴传输层的使用增强了客体发射,在低浓 度掺杂时就完全猝灭主体发光.因此,PVK 在 PFO: I(ppy),体系的 EL 器件中起着非常重要的作用. PVK 在其中究竟起什么样的作用呢?从器件的能级 结构图(图 8)可以看出,PVK 的最低未占分子轨道 (LUMO)能级高出 I(ppy),的 LUMO 能级 0.2 eV,和 PFO 的 LUMO 能级也有 0.5 eV 的能级差.因此,PVK 可以有效地将从阴极注入的电子阻挡在其与 PFO 的界面处,使器件的发光中心位于 PVK/PFO 界面 处.虽然发光层的溶剂甲苯不是 PVK 的良溶剂,但 在 PVK 上旋涂发光层会对其造成一定程度的溶解, 形成薄的互溶层.由于 PVK 高的三线态能级(2.5 eV)^{15]},界面处 PVK 到 L(ppy), 的能量转移增强了 L(ppy), 的发光,从而得到了高效率的绿光发光.

PVK + 40% PBD 主体的器件的效率低于 PFO 主体,可能的原因是 PVK 中空穴迁移率与电子迁移率 相差悬殊,造成发光层电子和空穴电流的不平衡.虽 然加入电子传输材料 PBD 后,电子的传输情况有所 改观,但是仍有待改进.



图 8 器件能级结构示意图

4.结 论

共轭聚合物的三线态能级一般要低于绿色磷光 材料的三线态能级,因此用作绿色磷光染料的主体 时容易发生从绿色磷光染料到主体的能量后转移, 而得不到有效的绿光发光.我们通过加入空穴传输 层 PVK,即采用器件结构 ITO/PEDOT/PVK/PFO: Id(ppy),/Ba/Al,得到了高效率的绿光发光.PVK高的 LUMO 能级有效阻挡了从阴极注入的电子,使得发 光中心靠近 PVK 与 PFO 的界面.由于 PVK 的三线 态能级较高,界面处 PVK 到 Id(ppy),的能量转移有 效增强了绿光发光.当掺杂浓度为 2%时,得到最高 效率的绿光发光,亮度效率为 24.8 cd/A,最高亮度 达到 35054 cd/m².而常用的 PVK 主体的绿光发光的 亮度效率为 20 cd/A,最高亮度为 17784 cd/m².

感谢华南理工大学高分子光电材料与器件研究所的彭 俊彪和曹镛教授的指导 感谢张勇博士提供材料。

- [3] Niu Q Shao Y Xu W Wang L Han S Liu N Peng J Cao Y Wang J 2008 Org. Electron. 9 95
- [4] De Gans B J ,Duineveld P C ,Schubert U S 2004 Adv. Mater. 16 203
- [5] Sun M, Niu Q, Du B, Peng J, Yang W, Cao Y 2007 Macromol. Chem. Phys. 208 988
- [6] Sudhakar M ,Djurovich P I ,Hogen-Esch T E ,Thompson M E 2003 J. Am. Chem. Soc. 125 7796
- [7] Chen F C ,He G F ,Yang Y 2003 Appl. Phys. Lett. 82 1006
- [8] Zhu W G ,Mo Y Q ,Yuan M ,Yang W ,Cao Y 2002 Appl. Phys. Lett. 80 2045
- [9] Dedeian K ,Djurovich P I ,Garces F O ,Carlson G ,Watts R J 1991

Inorg. Chem. 30 1685

- [10] Miyaura N Suzuki A 1995 Chem. Rev. 95 2457
- [11] Niu Q ,Xu Y ,Jiang J ,Peng J ,Cao Y 2007 J. Lumin . 126 531
- [12] Zhang X Jiang C ,Mo Y ,Xu Y ,Shi H ,Cao Y 2006 Appl. Phys. Lett. 88 051116
- [13] Tang X Q ,Yu J S Li L ,Wang J Jiang Y D 2008 Acta Phys. Sin.
 57 6620 (in Chinese)[唐晓庆、于军胜、李 璐、王 军、蒋亚 东 2008 物理学报 57 6620]
- [14] Noh Y Y ,Lee C L ,Kim J J ,Yase K 2003 J. Chem. Phys. 118 2853
- [15] Chen F C , Chang S C , He G F , Pyo S , Yang Y , Kurotaki M Y , Kido J 2003 J. Polym. Sci. B 41 2681

High efficiency phosphorescence light-emitting diodes with conjugated polymer host *

Niu Qiao-Li[†] Zhang Yong Fan Guang-Han

(Institute of Optoelectronic Materials and Technology, South China Normal University, Guangzhou 510631, China) (Received 24 March 2009; revised manuscript received 28 April 2009)

Abstract

Polymer hosted phosphorescent light-emitting diodes (PLEDs) were attractive because of their high efficiency light-emission and easy fabrication technology using solution process. For green phosphorescence PLEDs ,non-conjugated polymer ,such as poly (*N*-vinylcarbazole) (PVK), were often used as host ;while conjugated polymer have been proved to quench phosphorescence emission because of their low-lying triplet energy level. In this article ,high efficiency phosphorescent green-emission was obtained with conjugated polymer of poly (9,9-dioctylfluorene) (PFO) as host using the device structure of ITO/poly (ehtlenedioxythiophene): poly(styrene sulfonic acid) (PEDOT:PSS) (50 nm)/PVK(40 nm)/emissive layer(EML) (80 nm)/ Ba(4 nm)/Al(150 nm). The EML were PFO doped with different concentration of fac-tris (2-phenylpyridine) iridium(III) (Ir (ppy)₃) in weight. The PLED with 2 wt% In(ppy)₃ demonstrated the maximum luminous efficiency of 24.8 cd/A at current density of 4.65 mA/cm² and power efficiency of 11 lm/w with the peak emission at 520 nm. The luminance reached 35054 cd/ m² at the current density of 265 mA/cm². According to analyzsis ,the hole transport layer PVK can play important role in obtaining highly efficient green light emissing ,whose electrons blocking effect resulted in the interfacial emissing center , and then the interfacial PVK enhanced green emission through energy transfer due to its high triplet energy level.

 $\label{eq:keywords:conjugated polymer, phosphorescence, green emission \\ PACC: 7865T, 7280L, 7860F, 7855K \\$

^{*} Project supported by the Natural Science Foundation of Guangdong Province , China (Grant No. 06300928) and the Scientific Research Foundation for Doctor of South China Normal University , China (Grant No. G21027).

[†] E-mail : glniu@scnu.edu.cn